|  |
| --- |
|  |
| 量子器件中心（SQDL）用户流片新项目评审申请表 |
| **1. 课题组名称：**单位-部门-课题组名称 **SQDL注册用户申请名单：**  |
| **2. 项目名称：** |
| **3.项目来源：□国家级科研项目 □省部级科研项目 □市级科研项目 □其他项目** |
| **4. 项目的背景、重要价值与意义(200字以上)：**  |
| **5. 流片工艺流程（以下内容须详细写明，以便评审交叉污染）** |
| **原片介绍** | 4英寸硅片（以下为样例，申请时请删除） |
| **流片步骤** | **流片工艺内容** | **当前暴露出来的材料** | **蒸镀/刻蚀材料** | **申请使用的****设备** | **本步工艺结束后衬底上暴露出来的材料** | **对交叉污染的要求** | **备注** |
| 1 | 光刻 | **Si** | **/** | 匀胶显影通风橱、MA6,MLA,Track | AZ5214+Si | 无 | 　 |
| 2 | 薄膜蒸镀 | AZ5214+Si | Ti/Au | 多源炉电子束蒸发系统金属镀膜 | Au | 　 | 　 |
| 3 | Liftoff | Au | / | 有机清洗通风橱 | Au+Si | 　 | 　 |
| 4 | 光刻 | Au+Si | / | 匀胶显影通风橱、MA6,MLA,Track | AZ5214+Si | 　 | 　 |
| 5 | 刻蚀 | AZ5214+Si | Si | HBr刻蚀机硅刻蚀(Plasma Pro 100 Cobra 180) | AZ5214+Si | 　 | 　 |
| 6 | 去胶 | AZ5214+Si | / | 等离子去胶机、有机清洗通风橱 | Si | 　 | 　 |
| 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|

|  |
| --- |
| 备注： |
| 1.为准确开展技术评审工作，请提供最终的加工结构示意图作为此表附件材料。 |
| 2. 如需组织专家进行外审，需准备项目汇报 PPT（此条需待评审人员进行初步评审之后，将邮件回复项目负责人准备）。 |
| 3.本评审通过后，中心技术业务部相关老师将直接邮件反馈审核结果。 |
| 4.本评审通过的课题组或个人，方可开展用户注册申请和安全培训或开展新工艺流程等。 |
| 5.如贵课题组或用户个人，在进入中心净化室工作后，需进行新的工艺技术流片步骤的（即产生了“新项目”），请再填写此表格，并按照流程，申请新项目的工艺流片评审。如未通过新项目的评审，而在中心净化室内直接进行工艺操作的，被发现的，中心将通报批评，并取消用户资格，严重的将追究其赔偿责任，并上报校相关部门处罚。 |
| 6.本表及附件扫描后，请发至邮箱SQDL@shanghaitech.edu.cn。 |

 |

课题组负责人（签字）： 日期：

申请成为用户的人员（签字）：